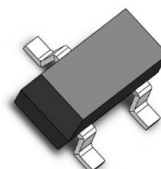


LYNM3400S1P 型 N 沟道 MOS 场效应晶体管

1 特性

- 开关速度快，输入阻抗高；
- 安全工作区宽，温度稳定性好；
- 静电敏感等级：1B；
- 封装形式：SOT-23；



2 质量等级及执行标准

G 级：QZJ840611，Q/RBJ1019QZ-2015。

3 最大额定值

最大额定值见表 1，除另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}$ 。

表 1 最大额定值

参数 产品型号	$P_D$ (mW)	$BV_{DSS}$ (V)	$V_{GS}$ (V)	$I_D$ (A)	$R_{DS(on)}$ (m $\Omega$ )	$R_{th(j-A)}$ ( $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ )	$T_j$ ( $^{\circ}\text{C}$ )	$T_{stg}$ ( $^{\circ}\text{C}$ )
LYNM3400S1P	310	30	$\pm 12$	5.4	55.5	90	$-55\sim 150$	$-55\sim 150$

4 主要电特性

主要电特性（除非另有规定外， $T_A=25^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$ ）见表 2。

表 2 主要电特性

序号	参数名称	符号	测试条件	规范值		单位
				最小值	最大值	
1	漏源击穿电压	$BV_{DSS}$	$V_{GS}=0\text{V}$ , $I_D=250\mu\text{A}$	30	—	V
2	零栅压漏极电流	$I_{DSS}$	$V_{DS}=30\text{V}$ , $V_{GS}=0\text{V}$	—	1.0	$\mu\text{A}$
3	正向栅极漏电流	$I_{GSSF}$	$V_{GS}=12\text{V}$ , $V_{DS}=0\text{V}$	—	80	nA
4	反向栅极漏电流	$I_{GSSR}$	$V_{GS}=-12\text{V}$ , $V_{DS}=0\text{V}$	—	-80	$\mu\text{A}$
5	开启电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS}=V_{GS}$ , $I_D=250\mu\text{A}$	0.7	1.5	V
6	导通电阻	$R_{DS(on)1}$	$V_{GS}=10\text{V}$ , $I_D=5.7\text{A}$	—	55.5	m $\Omega$
		$R_{DS(on)2}$	$V_{GS}=4.5\text{V}$ , $I_D=5\text{A}$	—	60	m $\Omega$
		$R_{DS(on)3}$	$V_{GS}=2.5\text{V}$ , $I_D=3\text{A}$	—	70	m $\Omega$
7	跨导	$g_{fs}$	$V_{DS}=5\text{V}$ , $I_D=5.7\text{A}$	10	—	S

8	电容	$C_{iss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	700	pF
		$C_{oss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	200	pF
		$C_{rss}$	$V_{DS}=5V, V_{GS}=0V, f=1.0MHz$	—	120	pF

## 5 特性曲线

### 5.1 不同栅源电压、不同漏源电压下的漏极电流曲线

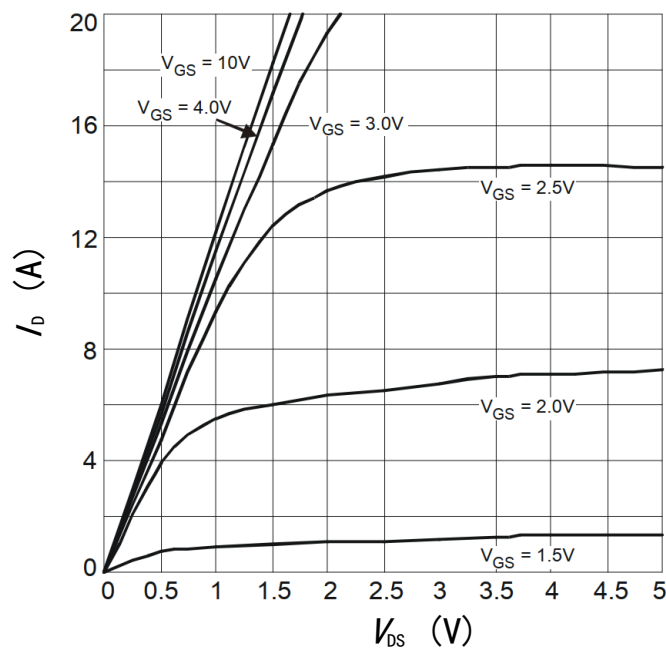


图 1 开启区域特性曲线

### 5.2 不同温度、不同栅源电压下的漏极电流曲线

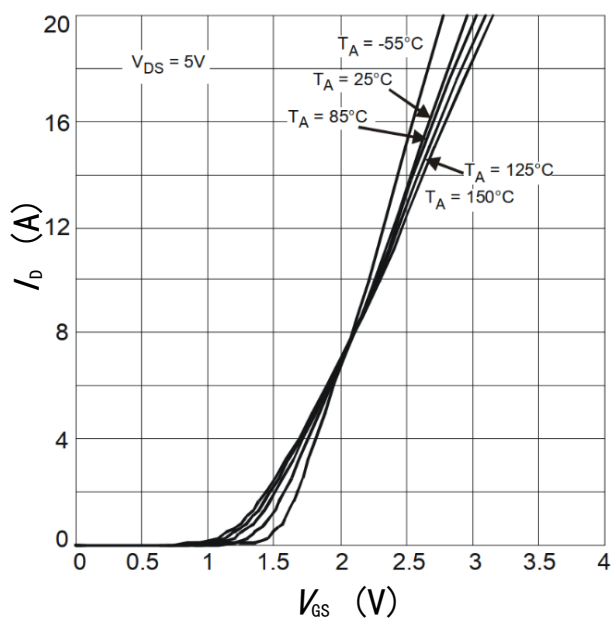
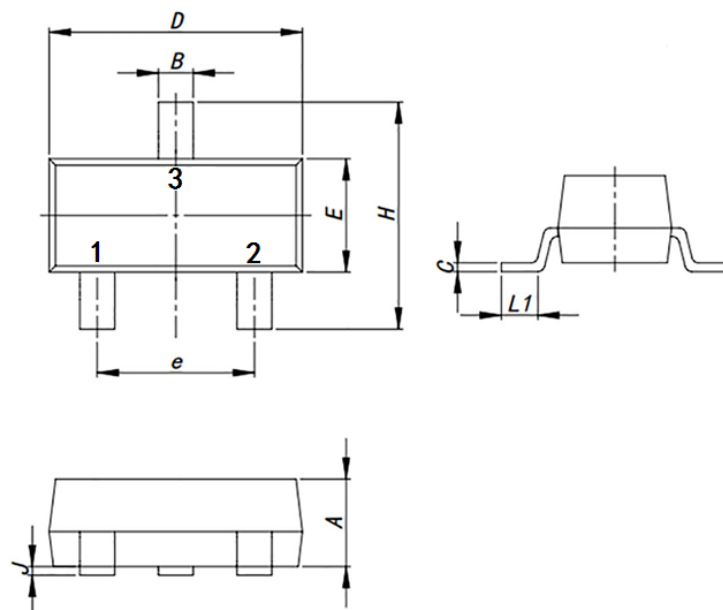


图 2 转移特性曲线

## 6 外形尺寸



引出端：1-栅极 G，2-源极 S，3-漏极 D

图 3 SOT-23 外形尺寸图

单位:mm

符号 尺寸	$A$	$B$	$C$	$D$	$E$	$e$	$J$	$H$	$L_1$
最小值	0.90	0.30	0.08	2.70	1.20	1.70	—	2.20	0.15
最大值	1.30	0.50	0.18	3.10	1.60	2.10	0.10	3.00	0.45